【施設供用募集対象装置の設備仕様】

No.	設備·装置の種類	装置の概要・条件	担当者·連絡先	備考
1	J-KAREN-Pレーザー装置	極短パルス・超高強度レーザー 1)パワーアンプモード 中心波長: 810 nm パルスエネルギー: ~1 J パルス幅: 30~50fs 繰り返し: 10 Hz (1Hz、シングルショットも可能) 2)ブースターアンプモード 中心波長: 810 nm ターゲット照射エネルギー: ~10 J パルス幅: 30~50fs 繰り返し:10秒/shot (シングルショットも可能) 3)プラズマミラーモード コントラスト: ブースターアンプモードより3桁改善	宮坂泰弘 TEL:0774-80-8706	(木津) 実験棟 C103号室
2	kHzチタンサファイアレーザー	高繰り返しレーザー 波長:800nm パルスエネルギー:2mJ パルス幅:50fs 繰り返し:1kHz	遠藤友随 TEL:0774-80-8903	(木津) 実験棟 C102号室
3	X線回折装置	X線回折装置(リガク:SLX2000) 1)ターゲット:Cu (真空封止型(最大3kW)) 2)高精度ゴニオメータ搭載 3)小角X線散乱測定による多層膜等の薄膜評価 4)各種解析ソフト搭載(GXRR等) 成膜装置(㈱大阪真空) 1)ターゲット数:4元(5インチ角) 2)成膜プロセス:シーケンサによる自動成膜(手動も可) 3)膜厚制御法:シャッターによる時間制御(分解能0.1s) 4)基板:050mm×12mmt(最大)、2個、自公転式	石野雅彦 TEL:0774-80-8817	(木津) 実験棟 C128号室
4	QUADRA-Tレーザーシステム	QUADRA-Tレーザーシステム 波長:1030nm パルスエネルギー:20mJ パルス幅:1ps 繰り返し:5kHz	石井順久 TEL:0774-80-8873	(木津) 実験棟 C102号室